

厚膜ハイブリッド回路 I H形

お客様との打合せにより RoHS対応致しております。 >

搭載部品

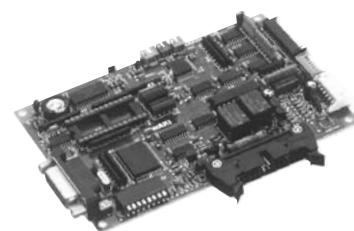
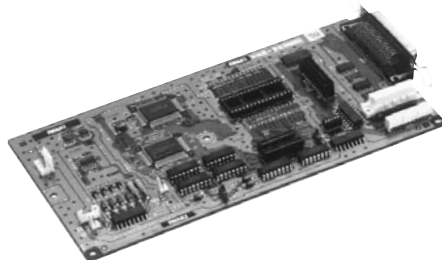
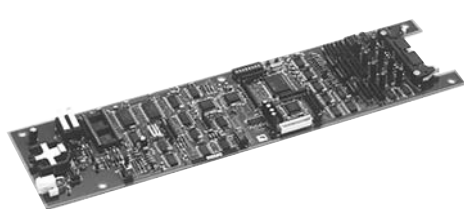
部 品	仕 様	
抵 抗	抵抗値範囲	10 ~ 10M (10 以下も可能)
	電力	30mW ~ 500mW
	許容差	± 5% , ± 10% (± 1%も可能)
	温度係数	± 150PPM/ °C , ± 300PPM/ °C
チップコンデンサ (セラミック)	容量値	1pF ~ 1.5μ F
	許容差	± 5% , ± 10% , ± 20% , ± 80%
	定格電圧	15V, 25V, 50V, 100V, 500V.D.C
	温度特性	0± 30PPM/ °C (- 55 ~ + 125) 0± 60PPM/ °C (- 55 ~ + 125) ± 15% (- 55 ~ + 125) + 22% ~ - 82% (- 30 ~ + 85)
チップコンデンサ (タンタル)	容量値	0.01μ F ~ 68μ F
	許容差	± 20%
	定格電圧	4V ~ 35V.D.C
ミニトランジスタ	一般用	Pc: 150~ 1000mW, Ic: 10~ 3000mA, Vce0: 15~ 120V
	高周波用	fr: 7GHz
	高圧スイッチング用	Vce0: 500V
	高電力用	Ic: 5A
	パワー	Pc: 10~ 20W, Io: 0.8~ 5A, Vce0: 30~ 400V
	ダーリントン	Pc: 10~ 15W, Ic: 1~ 4A, Vce0: 30~ 80V hfe: 1000Min
ミニ F E T ミニダイオード	低周波増幅, 高周波増幅, スwitchング用	
	スイッチングダイオード	Ic: 100mA, Vr: 30~ 100V
	ツェナーダイオード	Vz: 2.4~ 39V, Pc: 150~ 1000mW
半導体 I C	TTL 74シリーズ, 74LSシリーズ相当, その他	
	CMOS 4000シリーズ, 5000シリーズ相当, CPU, RAM, ROM, その他	
	オペアンプ, コンパレータ	
	その他 IC タイマー, トランジスタアレー他	
その他組み 可能素子	サーミスタ, サイリスタ, チップインダクタ, その他 ディスクリート部品	

プリント基板ユニット T Y P E - I B

お客様との打合せにより RoHS対応致しております。 >

特 長

厚膜ハイブリッド I C の搭載技術を基盤として各種の個別部品 (抵抗 , コンデンサ等) 回路素子 (半導体 , I C) を , 小型に一体化し機能トリミングにより完全調整したプリント基板ユニット (片面両面インサート) を短期間に供給致します。



お客様へ

- お客様の回路機密を厳守致します。
- プリント基板ユニットの設計検討をお客様と協力して行ないます。お気軽にご相談下さい。